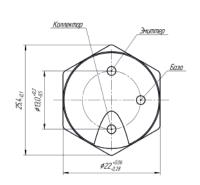
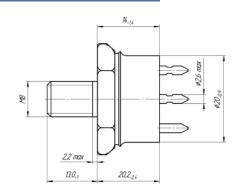
транзисторы КТ879А, КТ879Б

Кремниевые эпитаксиально-планарные n-p-n мощные переключательные транзисторы в металлокерамическом корпусе предназначены для работы в мощных ключевых устройствах.



Масса транзистора не более 28 г.





корпус КТ-5

Транзисторы соответствуют АДБК.432.140.131ТУ.

Таблица 1. Основные электрические параметры при T= 25°C

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		KT879A	КТ879Б
Граничное напряжение (I_{κ} = 0,1 A), В	U _{кэОгр}	≥150	≥100
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В			
$(I_K = 20 \text{ A}, I_B = 2 \text{ A})$	UКЭ нас	≤2	
$(I_K = 20 \text{ A}, I_b = 5 \text{ A})$			≤2,5
Напряжение насыщения база-эмиттер, В			
$(I_K = 20 \text{ A}, I_B = 2 \text{ A})$	U _{БЭ нас}	≤1,8	
$(I_K = 20 \text{ A}, I_B = 5 \text{ A})$]		≤2
Статический коэффициент передачи тока			
$(U_{K3} = 4 \text{ B}, I_{K} = 20 \text{ A})$	h ₂₁₉	≥10	
$(U_{K9} = 5 \text{ B}, I_{K} = 15 \text{ A})$			≥10
Обратный ток коллектора, мА			_
(U _{KBO} = 200 B)	I _{KБО}	≤3	
$(U_{KBO} = 150 \text{ B})$			≤3
Обратный ток эмиттера, мА			_
$(U_{350} = 6 B)$	I _{ЭБО}	≤10	
(U ₃₅₀ = 5 B)			≤20
Время спада, мкс			
$(U_{K3} = 100 \text{ B}, I_{K} = 20 \text{ A}, I_{E1} = I_{E2} = 2 \text{ A})$	t _{en}	≤0,5	
$(U_{K3} = 50 \text{ B}, I_{K} = 20 \text{ A}, I_{E1} = I_{E2} = 5 \text{ A})$			≤1,5



Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		KT879A	КТ879Б
Время рассасывания, мкс			
$(U_{K9} = 100 \text{ B}, I_K = 20 \text{ A}, I_{E1} = I_{E2} = 2 \text{ A})$	t _{pac}	≤1,5	
$(U_{K3} = 50 \text{ B}, I_{K} = 20 \text{ A}, I_{E1} = I_{E2} = 5 \text{ A})$			≤2
Энергия вторичного пробоя (U_{E3} = -1 B, R_{E3} = 50 Ом, L = 10 мГн), мДж	E _B	≥100	≥100

Таблица 2. Предельно допустимые режимы эксплуатации

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		KT879A	КТ879Б
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер (R_{E3} = 10 Ом), В	U _{KЭ max}	200	150
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В	U _{KБ max}	200	150
Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер (R_{E3} =100 Ом), В	U _{кэ, и тах}	200	150
Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В	U _{ЭБ тах}	6	6
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А	I _{K max}	50	50
Максимально допустимый импульсный ток коллектора при U _{эь} = 2 B, A	I _{К, и max}	75	75
Максимально допустимый постоянный ток базы, А	I _{Б max}	20	20
Максимально допустимый импульсный ток базы, А	I _{Б, и тах}	30	30
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт	P _{K max}	250	250